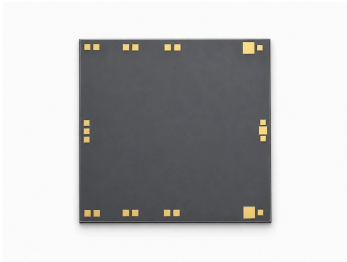


11500–18000 MHz GaN MMIC パワーアンプ・ベアダイ

PSAT: 44 dBm (最小値) / 44.5 dBm (標準値); 電力利得: 19 dB (最小値) / 19.5 dB (標準値); PAE: 28 % (最小値) / 30 % (標準値). ダイ寸法: 3.52 × 3.55 × 0.1 mm.



RF 特性 ・ TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 μs; D = 10%

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
動作周波数	f	11500	-	18000	11500–18000	MHz
飽和出力電力	Psat	44	44.5	-	-	dBm
電力利得	Gp	19	19.5	-	-	dB
電力利得平坦度	ΔGp	-	-	±0.5	-	dB
電力付加効率	PAE	28	30	-	-	%
小信号利得	S21	28	29	31	-	dB
小信号利得平坦度	ΔS21	-	-	±1.5	-	dB
入力 VSWR	VSWR(in)	-	1.8	2	-	-

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
ドレイン電圧	Vd	-	28	-	-	V
ゲート電圧	Vg	-	-2.4	-	-	V
ドレイン静止電流	Id	-	-	-	1.85 (Vd = +28 V; 調整可能な値です。資料には最小値・標準値・最大値の区分がありません。)	A

絶対限界値

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	Vd	-	-	32	V
ゲート・バイアス下限	Vg	-5	-	-	V

絶対限界値

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大入力電力	Pin	-	-	28	dBm
保存温度	TSTG	-65	-	150	°C
最大チャネル温度	Top	-	-	200	°C

ダイ寸法

項目	値	単位
ダイ寸法	3.52 × 3.55 × 0.1	mm

現在の発行記録 · 1.4 · 2026-10-26. 製品説明または編集内容を更新しました。置き換え対象の改訂版 1.3.

ダイ実装とバイアスの印加順序

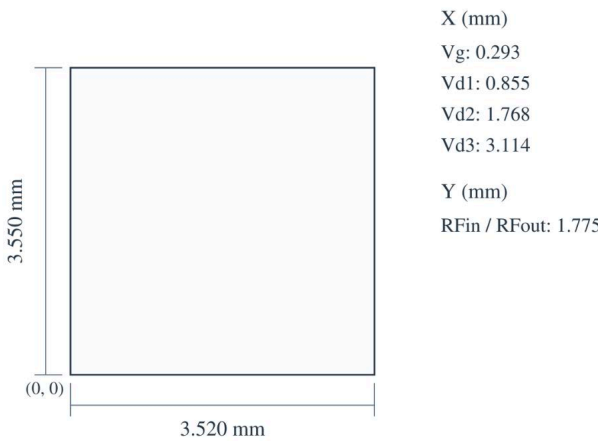
内蔵 DC ブロック: RFin / RFout. 接地への DC 経路: RFin / RFout → GND. 内部接続されたゲートパッド: Vg ↔ Vg. 別条件での特性評価: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 μs; D = 10%. ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

機械参照図の適用範囲

原資料に基づく外形と明記された座標の参照図です。単位は mm。完全な製造図面やワイヤボンディング図ではありません。

外形寸法図

LCI-PA-11500-18000-PS44p5T



3.520 × 3.550 × 0.100 mm

X, Y: ±0.100 mm

X → · Y ↑ · X, Y: mm

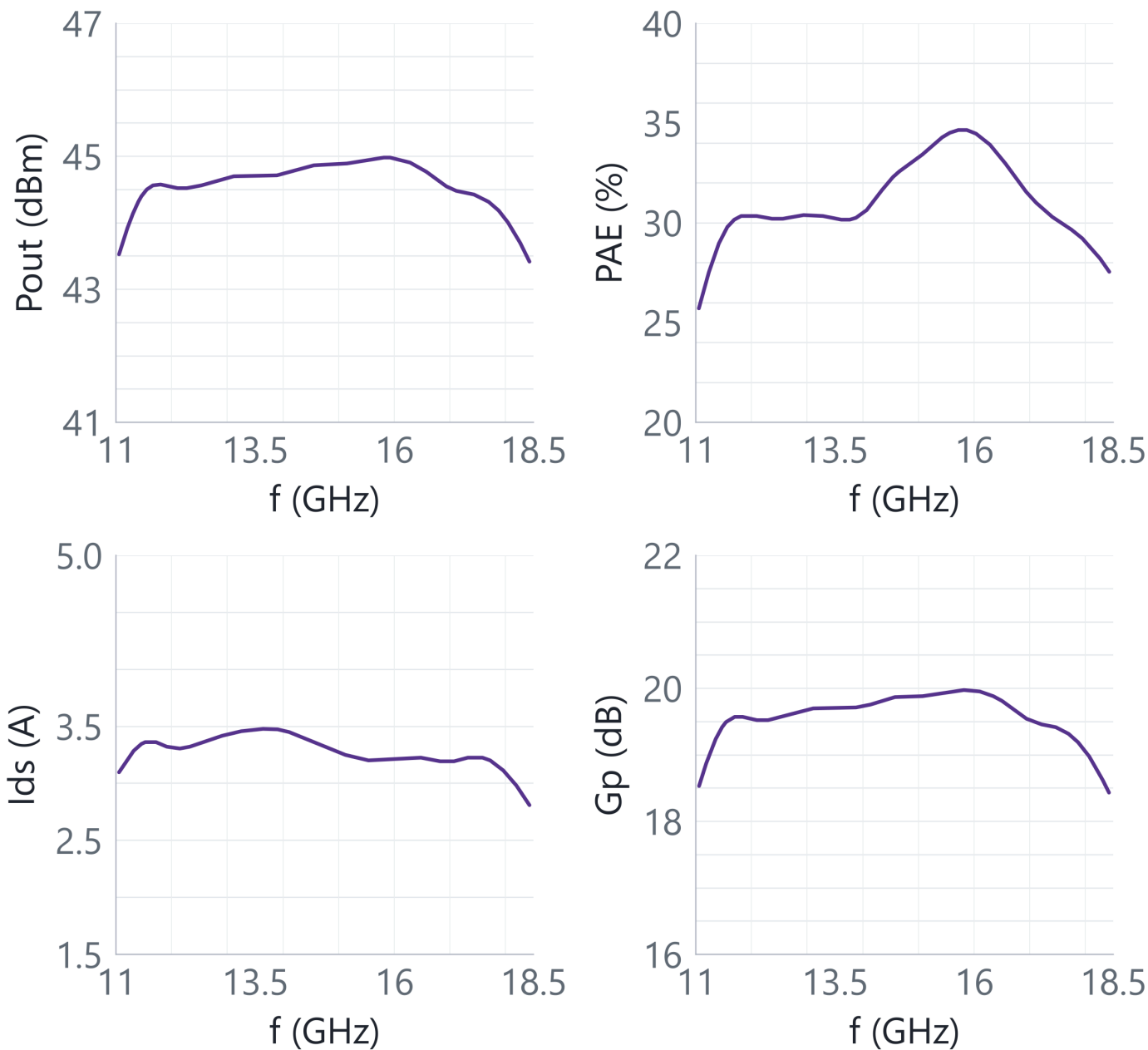
寸法の単位はすべて mm [in] です。

性能特性曲線

元のデータシートに掲載されたグラフです。各図に記載された動作条件と併せてご確認ください。

パルス動作－飽和出力電力、ドレイン動作電流、電力付加効率、電力利得。

原資料ページの記載：TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.4V; Pin=25dBm。パルス幅=100 μ s、デューティ比=10%。元画像からデジタイズして再描画した図です。読み取り値は近似値です。



[出典](#)

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。